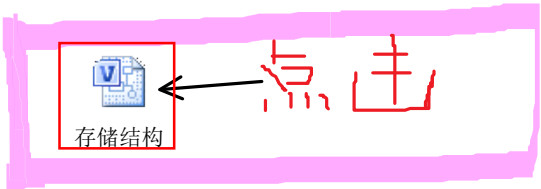


存储规划

2016年8月9日
10:03



存储规划: **cpuflash** 最后两个个扇区: 编号**14**、**15**、, 分别大小**32K**, 用于存储参数, **14**和**15**扇区交替存储, 擦平衡, 增加使用寿命。

调整目的: 鉴于**cpuflash**的 最小**256bytes**的擦除特性, 为了减少擦写频率, 将存储结构进行**256**对齐调整。

调整原则: 结合结构体大小, 参数修改频率等因素进行谨慎修改、调整。允许部分保留字节, 甚至从不用到。

调整结果: 读写任何参数可实现: 基地址+偏移地址+结构内偏移, 是程序更易读, 接口调用更简洁。

9*128

描述	参数标志	起始页面	结束页面	扇区	该参数在系统结构中的偏移位置	结构大小
系统参数标志	SYS_PARAM_FLAGS	0	0	15	PARAM_OFFSET(RTU_PARAM_SAVE_FLASH, sys_param_flags),	256
DAC)MOD参数	SYS_PARAM_DAC_MOD	1	1	15		256
外部时钟参数	SYS_PARAM_EXT_CLK	2	2	15		256
频率参数	SYS_PARAM_FREQ	3	3	15		256
...						